

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成28年2月18日 (2016.2.18)

【公開番号】特開2014-153074(P2014-153074A)

【公開日】平成26年8月25日 (2014.8.25)

【年通号数】公開・登録公報2014-045

【出願番号】特願2013-20347(P2013-20347)

【国際特許分類】

G 2 1 K 4/00 (2006.01)

G 0 1 T 1/20 (2006.01)

【F I】

G 2 1 K 4/00 B

G 0 1 T 1/20 E

G 0 1 T 1/20 B

G 0 1 T 1/20 G

G 0 1 T 1/20 L

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月25日 (2015.12.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数のアルカリハライド系蛍光体の柱状結晶からなる蛍光体層を気相堆積法によって基板上に形成する蛍光体層形成工程と、

蛍光体層形成工程の後に、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す第 1 の加湿工程と、
前記第 1 の加湿工程の後に、加湿処理を中断した状態を維持する第 1 の中断工程と、
前記第 1 の中断工程の後に、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す第 2 の加湿工程と、
前記第 2 の加湿工程の後に、加湿処理を中断した状態を維持する第 2 の中断工程と、
を備えることを特徴とする放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 2】

前記第 1 の加湿工程においては、前記蛍光体層の周囲を 20 以上 30 以下の温度、及び、45%以上 60%以下の相対湿度の環境下とすることにより、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す、ことを特徴とする請求項 1 に記載の放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 3】

前記第 1 の中断工程においては、前記蛍光体層の周囲を 20 以上 30 以下の温度、及び、10%以下の相対湿度の環境下とすることにより、加湿処理の中断を維持する、ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 4】

前記第 2 の加湿工程においては、前記蛍光体層の周囲を 20 以上 30 以下の温度、及び、35%以上 60%以下の相対湿度の環境下とすることにより、前記蛍光体層に対して加湿処理を施す、ことを特徴とする請求項 1～3 のいずれか一項に記載の放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 5】

前記第 2 の中断工程においては、前記蛍光体層の周囲を 20 以上 30 以下の温度、及び、10%以下の相対湿度の環境下とすることにより、加湿処理の中断を維持する、こ

とを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 6】

前記 1 の加湿工程の前において、前記蛍光体層に対して加熱処理を施す加熱工程をさらに備える、ことを特徴とする請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の放射線像変換パネルの製造方法。

【請求項 7】

ファイバオプティックプレートからなる基板と、

前記基板上に形成された複数の CsI 柱状結晶からなる蛍光体層と、

を備え、

前記蛍光体層においては、前記基板側において前記 CsI 柱状結晶同士が融着している

、

ことを特徴とする放射線像変換パネル。

【請求項 8】

前記蛍光体層を被覆するように前記蛍光体層上に形成された保護膜をさらに備える、ことを特徴とする請求項 7 に記載の放射線像変換パネル。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0017】

ここで、放射線像変換パネルは、ファイバオプティックプレートからなる基板と、気相堆積法により基板上に形成された複数の CsI 柱状結晶からなる蛍光体層と、を備え、蛍光体層には、潮解処理が施されていることを特徴とする。